

МАЛОУГЛОВОЕ РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ

И РЕНТГЕНОВСКИХ ЛУЧЕЙ

В ИССЛЕДОВАНИЯХ ЗОЛЬ-ГЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ

Г.П. Копица ФГБУ «ПИЯФ» НИЦ КИ, Гатчина, Россия



Это технология синтеза нанокомпозиционных, наноразмерных неорганических и органо-неорганических материалов, включающая получение золя с последующим переводом его в *гель*, то есть в коллоидную систему, состоящую из жидкой дисперсионной среды, заключенной в пространственную сетку, образованную соединившимися частицами дисперсной фазы.

Французский химик J. Ebelmen

- 1844 г. Получение тетраэтоксисилана Si(Oet)₄ (ТЭОС);
- 1846 г. Гидролиз ТЭОС с превращением в гель.
- 1981 г. первый международный симпозиум "Glasses and Glass Ceramics from Gels" становление золь-гель технологии, как самостоятельного научного направления;
- 1990 г. С. Jeffrey Brinker и George W. Scherer "Sol-Gel Science. The Physics and Chemistry of Sol-Gel Processing".

Золи – самоорганизующиеся и структурирующиеся системы



Основополагающие реакции, ответственные

за процессы структурообразования в золях гидролиз с образованием силанолов

 $(RO)_3 \equiv Si - OR + H_2O \leftrightarrow (RO)_3 \equiv Si - OH + ROH$

реакция ангидроконденсации

$$\equiv Si-OH + HO-Si \equiv \leftrightarrow \equiv Si-O-Si \equiv + H_2O$$

гетерофункциональная конденсация

$$\equiv Si - OR + HO - Si \equiv \leftrightarrow \equiv Si - O - Si \equiv + ROH$$

R-алкильные группы $C_{x}H_{2x+1}$

Схематическое изображение структурообразования в золях



Основные стадии золь-гель процесса получения различны материалов: *I*-созревание золя и гелеобразование: золь $(1) \rightarrow$ гель (2);II – сушка в суперкритических условиях или промывание геля в растворителях: гель $(2) \rightarrow аэрогель (3);$ III – сушка в обычных условиях: гель $(2) \rightarrow \kappa ceporenb (4);$ *IV-осаждение наночастиц:* золь $(1) \rightarrow$ порошок (6); *V*-нанесение золя на подложку: золь $(1) \rightarrow$ покрытие ксерогеля (7); VI – обжиг: ксерогель (4) или покрытие ксерогеля (7) — монолитные стекло и керамика (5) или покрытие (8)





Schaefer D.W., Keefer K.D. Fractal geometry of silica condensation polymers // Phys. Rev. Lett. 1984. V. 53. N. 14. P. 1383-1386.



Основные методы анализа фрактальных материалов

- методы, основанные на прямом использовании фрактальной размерности определения И топографии исследованием связанные С поверхности и построением различного рода покрытий поверхности (методы адсорбции и ртутной порометрии, методы численной обработки микрофотографий и др.);
- методы, основанные на анализе фурье-образов фрактальных объектов, полученных при рассеянии ими света, рентгеновских лучей, электронов или нейтронов.

Малоугловое рассеяние





Интенсивность малоуглового рассеяния:

 $I(Q) = \phi \cdot P(Q) \cdot S(Q)$

Фактор P(Q) связан с форм фактором частицы:

 $P(Q) = \left\langle \left| F(Q) \right|^2 \right\rangle$

Форм фактор частицы:

$$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{Q}) = \int_{V} |\boldsymbol{\rho}(\boldsymbol{r}) - \boldsymbol{\rho}_{0}| \exp(\boldsymbol{i}\boldsymbol{Q}\boldsymbol{r}) d\boldsymbol{r}$$

Плотность амплитуды рассеяния:

 $\boldsymbol{\rho}(\overset{\boldsymbol{\omega}}{\boldsymbol{r}}) = \sum_{i} \boldsymbol{b}_{i} \boldsymbol{\delta}(\overset{\boldsymbol{\omega}}{\boldsymbol{r}} - \overset{\boldsymbol{\omega}}{\boldsymbol{r}_{i}})$

Контраст: $\Delta \rho = \rho(r) - \rho_0$

Структурный фактор S(Q) связан с корреляционной функцией:

$$S(Q) = 1 + \phi \int |g(r) - 1| \exp(iQr) dr$$





Неоднородности с гладкой поверхностью и распределением рассеивающей плотности:

$$\rho(r) = \begin{cases} 0, & r > r_0 \\ const, & r < r_0 \end{cases}$$

где: *r*₀ — радиус неоднородности.

Корреляционная функция имеет вид:

$$g(r) = \exp(-\frac{r}{r_0})$$



Сечение рассеяния в пределе больших q:

[4] P.W. Schmidt, Modern Aspects of Small-Angle Scattering, Ed. H. Brumberger. Kluwer Academic Publishers, 30 (1995). Массовый (объемный) фрактал

$$M(r) = M_0 r^{D_m},$$
 где $1 \le D_m < 3$ и $r_0 < r < \xi$

Тогда, согласно [1], корреляционная функция имеет вид:

$$|g(r)-1| = \frac{D_m}{4\pi} \frac{1}{r_0^{D_m}} r^{D_m-3} \exp(-r/\xi),$$

Структурный фактор:

$$S(Q) = 1 + \frac{1}{(Qr_0)^{D_m}} \frac{D_m \Gamma(D_m - 1)}{(1 + \frac{1}{Q^2 \xi^2})^{(D_m - 1)/2}} \sin \left| (D_m - 1)tg^{-1}(Q\xi) \right|$$

При условии $1/\xi \ll Q \ll 1/r_0$:

$$\lim_{\xi\to\infty}S(Q)\cong (Qr_0)^{-D_m}$$





[1]Teixera, On Growth and Form-Fractal and Non-Fractal Pattern in Physics, Ed. by H.E. Stanley and N. Ostrovsky. Boston: Martinus Nijloff Publ., 145 (1986).





$$S(r) = r^2 \left(\frac{R}{r}\right)^{D_S},$$
 где $2 \le D_S < 3$

Согласно [2,3], корреляционная функция для поверхностного фрактала имеет вид:

$$g(r) = 1 - \frac{N_0 r^{3-D_s}}{4c(1-c)V}$$

где: N_0 — характеристика фрактальной границы, V — объем исследуемого образца. Величины D_8 и N_0 определяются соотношением:

$$n_r = N_0 r^{-D_s},$$

Сечение рассеяния:

$$\frac{d\Sigma(q)}{d\Omega} = \pi N_0 \rho^2 \frac{\Gamma(5 - D_S)}{q^{6 - D_S}} \sin[(D_S - 1)/2]$$



 $D_{\rm s} = 2.5$

В пределе больших q:

$$N_{0} = \frac{\lim_{q \to \infty} \left[q^{6-D_{S}} \frac{d\Sigma(q)}{d\Omega} \right]}{\pi \rho^{2} \rho_{0} F(D_{S})}$$

$$S = N_0 r^{2-D_S}$$

[2]P. Pfeifer, D. Avnir, J. Chem. Phys. V.79, 3558 (1983).[3] H.D. Bale, P.W. Schmidt, Phys.Rev. Lett. V.38, 596 (1984).



Специфический класс поверхностей с распределением рассеивающей плотности вблизи границы неоднородности [4]:

$$\rho(r) = \begin{cases} \rho_0, & a \le r \\ \rho_0(r/a)^{\beta}, & 0 \le r \le a \\ 0, & r < 0 \end{cases}$$



где: r — расстояние от точки внутри неоднородности до точки на ее границе, a — ширина «диффузного» слоя, внутри которого рассеивающая плотность возрастает от 0 до ρ_0 по степенному закону с показателем степени: $0 \le \beta \le 1$.

Сечение рассеяния [4]:

$$\frac{d\Sigma(q)}{d\Omega} = \frac{2\pi\rho_0^2 a^4 S[\Gamma(\beta+1)]^2}{(qa)^{4+2\beta}}$$

[4] P.W. Schmidt, Modern Aspects of Small-Angle Scattering, Ed. H. Brumberger. Kluwer Academic Publishers, 30 (1995).

Общие принципы малоуглового рассеяния



$$I_{\scriptscriptstyle S} \sim q^{\scriptscriptstyle -\Delta},$$
 при $qR>>1$

| Рассеивающая система | Показатель степени Δ |
|---------------------------------------|---|
| Массовый (объемный) фрактал | $1 \le D_{\rm m} < 3$ |
| Поверхностный фрактал | $3 < 6 - D_{\rm S} \le 4$ |
| Неоднородность с гладкой поверхностью | 4 |
| «Диффузная» поверхность | 4 + 2 β , где 0 $\leq \beta \leq 1$ |
| Сильно сплюснутая частица | 2 |
| Сильно вытянутая частица | 1 |



Мезоструктура и фрактальные свойства аморфных ксерогелей гидратированных ZrO₂ и HfO₂ и продуктов их термической и гидротермальной обработки

> Г.П. Копица, С.В. Григорьев ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина, Россия

В.К. Иванов, О.С. Иванова, А.Е. Баранчиков ИОНХ РАН, Москва, Россия

В. М. Гарамус, Р. Klaus Pranzas, M. Sharp GKSS Research Centre, Geesthacht, Germany

L. Almásy

Research Institute for Solid State Physics and Optics, Budapest, Hungary



- Изучение влияния кислотности (pH) среды на фрактальную структуру аморфных ксерогелей гидратированных диоксидов ZrO_2 и HfO_2 , синтезированных из водных растворов $ZrO(NO_3)_2$ и $HfO(NO_3)_2$;
- Изучение эволюции фрактальных характеристик ксерогелей гидратированного диоксида циркония ZrO₂ на разных стадиях термического разложения (в том числе в гидротермальных условиях) и под влиянием мощной ультразвуковой обработки.



Схема синтеза ксерогелей ZrO₂



Схема установки и параметры SANS-2



Параметры установки SANS - 2:

- · $\lambda = 3 \div 20$ Å c $\delta \lambda / \lambda = 10\%$;
- $I_0 = 2 \times 10^7 \text{ n/(sec \cdot cm^2)}$ при $\lambda = 5 \text{ Å и SD} = 1 \text{ m};$
- $2.6 \cdot 10^{-3} < q < 2.6 \cdot 10^{-1}$ Å⁻¹ используя четыре дистанции SD = 1, 3, 9 и 20.7 m;
- двумерный позиционно-чувствительный ³Не детектор.

Установка ультра малоуглового рассеяния нейтронов DCD (USANS)





Результаты



Зависимости SANS (a) и USANS (b) для образцов аморфных ксерогелей гидратированного ZrO_2 с pH = 3, 5, 7 и 9 от переданного импульса *q*.

Результаты



с pH = 4, 6, 8 и 9 от переданного импульса q.

SANS + USANS





Результаты





Фрактальные размерности для аморфных ксерогелей ZrO₂ и HfO₂ от pH.

1) SANS:

$$\frac{d\Sigma(q)}{d\Omega} = \frac{A_1(D_s)}{q^n} + A_2 \cdot \exp(-\frac{q^2 r_g^2}{3})$$

где:
$$A_1(D_s) = \pi \rho_0 \rho^2 \Gamma(5 - D_s) \sin[(D_s - 1)(\pi/2)] N_0$$

2) USANS:

$$I_{S}(q) = A_{3} \cdot \exp(-\frac{q^{2}R_{g}^{2}}{3}) + \frac{A_{4}(D_{S})}{(\hat{q})^{\Delta}}$$

где : $\hat{q} = q / [erf(qR_g / 6^{1/2})]^3$ - переданный импульс, нормированный на функцию ошибок erf(x).

 $\Delta = n + 1$

Результаты





Зависимости радиусов мономеров r_{θ} и агрегатов R_{θ} для аморфных ксерогелей гидратированных ZrO_2 (a) и HfO₂ (b) от pH среды.

Отжиг



Импульсные зависимости дифференциального сечения $d\Sigma$ (q)/ $d\Omega$ МУРН образцом ксерогеля ZrO_2 с pH = 6, полученные при разных T_a .

Зависимости фрактальной размерности $D_{\rm S}$ образцов гидратированного ZrO₂, синтезированных при различных значениях pH , от $T_{\rm a}$

Отжиг



Специфический класс поверхностей с распределением рассеивающей плотности вблизи границы неоднородности :

$$\rho(r) = \begin{cases}
\rho_0, & a \le r \\
\rho_0(r/a)^{\beta}, & 0 \le r \le a \\
0, & r < 0
\end{cases}$$

где: r — расстояние от точки внутри неоднородности до точки на ее границе, a ширина «диффузного» слоя, внутри которого рассеивающая плотность возрастает от 0 до ρ_0 по степенному закону с показателем степени: $0 \le \beta \le 1$.



Зависимость показателя степени β от температуры отжига для образцов с диффузной поверхностью, форми-рующихся при термической обработке ксерогеля с pH = 3.

Импульсные зависимости дифференциального сечения $d\Sigma$ $(q)/d\Omega$ МУРН образцом ксерогеля ZrO_2 с pH = 3, полученные при разных T_a .

Отжиг





Зависимости максимального размера индивидуальных частиц r_0 в образцах гидратированного ZrO_2 , синтезированных при различных значениях pH , от температуры отжига.

Гидротермальная обработка





Импульсные зависимости $d\Sigma(q)/d\Omega$ МУРН образцом ксерогеля ZrO₂ с pH = 7, полученные при разных $T_{\rm h}$.

Микрофотографии исходного ксерогеля ZrO_2 с pH = 7 до (а) и после гидротермальной обработки при $T_h = 130$ (b), 180 (c) и 225 °C (d).

Гидротермальная обработка





Зависимости фрактальной размерности $D_{\rm S}$ поверхности раздела фаз в образцах ксерогелей на основе гидроксида ${\rm ZrO}_2$ с pH = 4, 7, 8 и 9 от $T_{\rm h}$.

Влияние ультразвуковой обработки на мезоструктуру аморфных ксерогелей <u>гидратированного ZrO₂, синтезированного из пропилата циркония *Zr(OPr)*₄</u>





Влияние ультразвуковой обработки на мезоструктуру аморфных ксерогелей гидратированного ZrO₂, синтезированного из пропилата циркония Zr(OPr)₄





Зависимости дифферинциального сечения $d\Sigma(q)/d\Omega$ SANS для образцов аморфных ксерогелей гидротированного диоксида циркония, синтезированных из растворов солей пропилата циркония $Zr(OPr)_4$ без (а) и с применением (б) УЗ обработки. Сплошные линии – результат подгонки экспериментальных данных по формуле:

$$\frac{d\Sigma(q)}{d\Omega} = \frac{A_1(D_{S1})}{q^n} + G_p \cdot \exp(-\frac{q^2 r_g^2}{3}) + \frac{A2(D_{S2})}{\hat{q}^m} + I_{inc}$$

Влияние ультразвуковой обработки на мезоструктуру аморфных ксерогелей гидратированного ZrO₂, синтезированного из пропилата циркония Zr(OPr)₄





Зависимости фрактальной размерности D_{s1} (a) агрегатов, характерного размера r_c (б) и фрактальной размерности D_{s2} (в) первичных частиц аморфных ксерогелей гидратированного диоксида циркония, синтезированного из растворов пропилата циркония **Zr(OPr)**₄ без и с применением УЗ обработки, от pH среды синтеза.

Сравнение SANS и SAXS







Методами МУРН и УМУРН исследована мезоструктура аморфных ксерогелей гидратированного диоксида циркония.

- Впервые показано, что pH среды при осаждении гелей гидратированного ZrO₂ оказывает существенное влияние на фрактальные характеристики гелей, а также влияет на размеры кластеров и образующих их мономерных частиц.
- Установлено, что ключевым фактором, определяющим состав и структуру гелей, является отклонение pH осаждения гелей от pH, соответствующего изоэлектрической точке гидратированного ZrO₂(pH_{i.e.p} ≈ 6).
- Найдено, что найденные закономерности воспроизводятся для ксерогелей гидратированного диоксида гафния HfO₂ (при pH = 3, 4, 6, 7, 8 и 9), являющегося химическим аналогом циркония.
- Обнаружено, что отжиг ксерогелей ZrO₂ приводит к постепенному уменьшению фрактальной размерности D_S, в то время как гидротермальная обработка позволяет сохранять фрактальные свойства исходного образца.
- Показано, что УЗ обработка приводит к изменениям фрактальной размерности поверхности D_S кластеров, а также к уменьшению влияния условий синтеза (pH среды осаждения) на мезоструктуру конечных продуктов.



Механизм роста наночастиц диоксида циркония при отжиге и гидротермальной обработке

Г.П. Копица, С.В. Григорьев ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина, Россия

В.К. Иванов, О.С. Иванова, А.Е. Баранчиков ИОНХ РАН, Москва, Россия

B. M. Гарамус, P. Klaus Pranzas GKSS Research Centre, Geesthacht, Germany



- Изучение закономерностей изменения размеров частиц в нанодисперсных порошках диоксида церия с различной химической предысторией при нагревании в диапазоне температур от 200 до 700°С и определение преимущественного механизма роста частиц CeO₂.
- •Изучение закономерностей изменения размеров частиц CeO₂ при гидротермальной обработке (120–210°C) в нейтральной среде и определение преимущественного механизма их роста.





Структура флюорита (CaF₂). Гранецентрированная кубическая; a=5,411Å; пространственная группа Fm3m





Высокотемпературный рост наночастиц диоксида церия





Распределения частиц по размерам для образцов CeO_{2-х}, синтезированных быстрым осаждением из раствора нитрата церия(III) и отожженных при различных температурах.

Механизм роста наночастиц диоксида церия в гидротермальных условиях





Зависимости сечения dΣ(q)/dΩ МУРН образцами Ce-1 (1), Ce-210-15 (2) и Ce-210-180 (3) от переданного импульса q.

Механизм роста наночастиц диоксида церия в гидротермальных условиях





Функции распределения по размерам частиц $D_V(R)$ для образцов, синтезированных при различных температурах и продолжительностях ГТМВ обработки (*a* – образцы Ce-120°C-15мин (1) и Ce-210°C-15мин (2); *б* – образцы Ce-120°C-3ч (1) и Ce-210°C-3ч (2)).



- Данные МУРН свидетельствуют о том, что рост частиц CeO₂ в процессе отжига происходит не посредством перекристаллизации, а путем их последовательного сращивания. Действительно, наличие первого максимума на кривых распределения по размерам для образцов, отожженных при 600 и 700°С, показывает, что малые частицы, размер которых соответствует размеру частиц в исходных образцах, сохраняются даже при высокотемпературном отжиге CeO₂, а их доля постепенно убывает.
- Изменения микроморфологии порошков CeO₂ при увеличении температуры и продолжительности гидротермальной обработки хорошо согласуются с моделью роста частиц по механизму ориентированного присоединения. Об этом, в частности, могут свидетельствовать (а) неизменность положения первого максимума на кривых распределения, (б) особенности взаимного расположения первого и второго максимумов на кривых распределения (удвоение размеров частиц) и (в) изменение относительного вклада первого и второго максимумов при увеличении температуры и продолжительности ГТ-МВ синтеза.



НАНОЧАСТИЦЫ ФЕРРИТА КОБАЛЬТА В SiO₂-МАТРИЦЕ: СИНТЕЗ, СТРУКТУРА И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

Г.П. Копица, А.Е. Соколов ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина, Россия

О.А. Шилова, Т.В. Хамова ИХС РАН, Санкт-Петербург, Россия

А.Е. Баранчиков ИОНХ РАН, Москва, Россия



- Синтез наночастиц феррита кобальта в силикатной матрице золь-гель методом на основе золя тетраэтоксисилана (ТЭОС), гидролизованного в водно-спиртовой кислой среде в присутствии модифицирующих неорганических веществ Fe(NO₃)₃·9H₂O и Co(NO₃)₂·6H₂O;
- Изучение мезоструктуры и магнитных свойств наночастиц феррита кобальта в силикатной матрице, а также их эволюции в процессе термической обработки (отжиг);







Образцы

- **1.** CoFe₂O₄
- **2.** $CoFe_2O_4 SiO_2, 800^{\circ}C$
- **3.** $CoFe_2O_4 SiO_2$, 1000°C

Методы анализа

- Низкотемпературная адсорбция азота (ВЕТ, ВЈН);
- Растровая электронная микроскопия (РЭМ);
- Порошковая дифракция нейтронов;
- SAXS;
- SAPNS

Низкотемпературная адсорбция азота





Удельная площадь поверхности по методу БЭТ

- $CoFe_2O_4 \approx 150 \text{ m}^2/\text{g};$
- CoFe₂O₄ + SiO₂ (800°C) \approx 300 m²/g;
- $CoFe_2O_4 + SiO_2 (1000^{\circ}C) \approx 8 \text{ m}^2/\text{g};$

Распределение пор по размерам по методу ВЈН



Растровая электронная микроскопия





 WD = 3.2 mm Signal A = InLe System Vacuum = 1.77e-006 mbar Aperture Size = 30.00 µm EHT = 10.00 kV

^s Kurnakov Institute of General and Inorganic Chemistry

CoFeO₄

Растровая электронная микроскопия



$CoFeO_4 + SiO_2 (800^{\circ}C)$





erture Size = 30.00 µm EHT = 10.00 kV and Inorganic Chemistry



lag - 100.00 K X 200 nm ision 40-38-50 Photo No. - 5100 Date :7 Jul 2015

WD = 2.6 mm Signal A = ESB System Vacuum = 1.69e-006 mbar and Inorganic Chemistry rture Size = 30.00 µm EHT = 1.00 kV

 $CoFeO_4 + SiO_2 (1000^0C)$



NVision 40-38-50 ate :31 Mar 2015 Ph

System Vacuum = 1.94e-006 mbar and Inorganic Chemistry Aperture Size = 30.00 µm EHT = 1.00 kV



Mag – 100.00 K X 200 nm NVision 40-38-50 te :31 Mar 2015 Photo No. = 7502

Signal A = ESE Kurnakov Institute of General System Vacuum = 1.93e-006 mbar and Inorganic Chemistry Aperture Size = 30.00 µm EHT = 1.00 kV

Порошковая дифракция нейтронов





Данный образец имеет кубическую структуру с пространственной группой **Fd-3m** в обозначениях Германа-Могена и - **F4vw2vw3** в обозначениях Холла (N227, setting 2 по Международным кристаллографическим таблицам). Таким образом, структура исследуемого образца представляет собой частично инвертированную шпинель – и в тетраэдрических, и в октаэдрических позициях находятся как катионы Co^{2+} , так и **Fe**³⁺, и в целом формулу исследуемого вещества можно в первом приближении записать как (**Fe**_{0.73}**Co**_{0.27})(**Fe**_{0.63}**Co**_{0.37})₂**O**₄.

| $R_p = 42.6 R_{wp} = 35.4 R_e = 14.9 \chi^2 = 5.664$ | | | | | | | | |
|---|------|---------|-----------|-----------|-----------|--------|----------|--|
| a | атом | позиция | Х | Y | Ζ | В | заселен- | |
| | | | | | | | ность | |
| 8.385(2)Å | Co1 | 8a | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 4.1(4) | 0.27(1) | |
| | Fe1 | 8a | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 4.1(4) | 0.73(2) | |
| | Co2 | 16d | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2.3(3) | 0.37(1) | |
| | Fe2 | 16d | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2.3(3) | 0.63(2) | |
| | 0 | 32e | 0.2622(4) | 0.2622(4) | 0.2622(4) | 0.6(2) | 1.0 | |



Порошковая дифракция нейтронов



Порошковая дифракция нейтронов







Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей



3 pinhole collimation

Малоугловое рассеяние рентгеновских лучей





Зависимости интенсивности I_S(q) МУРР образцами феррита кобальта и феррита кобальта в силикатной матрице, от переданного импульса q.

$$\frac{d\Sigma(q)}{d\Omega} = \sum_{i=1}^{m} \left(G_i \cdot \exp\left(-\frac{q^2 R_{gi}^2}{3}\right) + B_i \exp\left(-\frac{q^2 R_{g(i-1)}^2}{3}\right) \left[\frac{\left(erf\left(qR_{gi} / \sqrt{6}\right)\right)^3}{q}\right]^{n_i} \right) + I_{inc}$$

Малоугловое рассеяние поляризованных нейтронов

Нейтрон имеет спин:

IXI

$$\overset{\boxtimes}{s} = \frac{\overset{\boxtimes}{\sigma}}{2} \qquad \longrightarrow \qquad \overset{\boxtimes}{P} = \langle \overset{\boxtimes}{\sigma} \rangle \qquad \longrightarrow \qquad P = \frac{I_+ - I_-}{I_+ + I_-}$$

Магнитный момент нейтрона:

$$\overset{\boxtimes}{\mu}_{n}=\mu_{n}\overset{\boxtimes}{\sigma}$$

Амплитуда рассеяния нейтронов:

$$F(\overset{\boxtimes}{q}) = F_N(\overset{\boxtimes}{q}) + \overset{\boxtimes}{M}_{\perp} \overset{\boxtimes}{\sigma}$$

Малоугловое рассеяние поляризованных нейтронов



Интенсивность МУР ансамблем Л магнитных частиц:

 $I(q) = \phi \cdot P(q)S(q)$

Форм – фактор рассеивающих частиц

$$P(q) = (\Delta \rho \cdot F_N(q) \pm \Delta \eta \cdot F_M(q))^2$$

При *S*(q) = 1:

 $I(q,\alpha) = (\Delta \rho)^2 F_N^2 + ((\Delta \eta)^2 F_M^2 \pm 2\Delta \rho \cdot \Delta \eta \cdot F_N F_M) \cdot \sin^2 \alpha,$



Неполяризованные нейтроны:

$$I(q,\alpha) = (\Delta \rho)^2 F_N^2 + (\Delta \eta)^2 F_M^2 \cdot \sin^2 \alpha.$$

Поляризованные нейтроны:

$$I^{+}(q,\alpha) = (\Delta \rho)^{2} F_{N}^{2} + ((\Delta \eta)^{2} F_{M}^{2} + 2P \cdot \Delta \rho \cdot \Delta \eta \cdot F_{N} F_{M}) \cdot \sin^{2} \alpha,$$
$$I^{-}(q,\alpha) = (\Delta \rho)^{2} F_{N}^{2} + ((\Delta \eta)^{2} F_{M}^{2} - 2P \varepsilon \cdot \Delta \rho \cdot \Delta \eta \cdot F_{N} F_{M}) \cdot \sin^{2} \alpha.$$

Магнитно-ядерная интерференция:

 $\Delta I(q,\alpha) = I^+(q,\alpha) - I^-(q,\alpha) = 2P(\varepsilon+1) \cdot \Delta \rho \cdot \Delta \eta \cdot F_N F_M \cdot \sin^2 \alpha$



$$\Delta I(q,\alpha) = I^+(q,\alpha) - I^-(q,\alpha) = 2P(\varepsilon+1) \cdot \Delta \rho \cdot \Delta \eta \cdot F_N F_M \cdot \sin^2 \alpha$$

- 1. Магнитно-ядерная интерференция возникает, только если оба типа рассеяния осуществляются в одной и той же области *q*-пространства, то есть когда рассеивающая среда одновременно характеризуется как ядерным, так и магнитным контрастом.
- **2.** Разница $\Delta I(q)$ пропорциональна двум слагаемым:

$$\Delta I(q) \propto 2 \operatorname{Re}\left[\left\langle \psi_{0} \psi_{M}^{*} \right\rangle + \left\langle \psi_{N} \psi_{M}^{*} \right\rangle \right]$$

При этом из закона сохранения числа частиц следует:

$$\int \Delta I(q) dq = 0$$

3. Метод измерения магнитно-ядерной интерференции является разностным, т.е. он само мониторированный с физически нулевым эффектом при отсутствии магнитно-ядерной интерференции.

Установка малоуглового рассеяния поляризованных нейтронов () PNPI



Схема малоуглового дифрактометра поляризованных нейтронов «ВЕКТОР» 1 – коллиматор, 2 – зеркальный фильтр, 3 – магнитный монохроматор, 4 – поляризатор, 5 – адиабатический флиппер, 6 – резонансный флиппер, 7 – анализатор, 8, 9 – адиабатические флипперы, 10 – узел образца, 11 – анализатор, 12 – 2-х координатный детектор (ПЧД).

Измерение поляризации



Феррит кобальта





Феррит кобальта в матрице SiO₂



$$T_{a} = 800^{0}C$$
 $\Delta I_{MN}(q) = \frac{A}{(q^{2} + \kappa^{2})^{2}} + \frac{B}{(q^{2} + \kappa^{2})}$ $R_{c} = 20 \pm 3 \text{ nm}$

 $T_{a} = 1000^{0}C$ $\Delta I_{MN}(q) = \frac{A}{(q^{2} + \kappa^{2})^{2}}$ H

$$R_{c} = 13.5 \pm 2 \text{ nm}$$

PNPI

Феррит кобальта в матрице SiO₂





KWS-1 Small angle scattering diffractometer



Феррит кобальта в матрице SiO₂













СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!